

# 0.65W,5KV<sub>RMS</sub> 耐压的全集成隔离 DC-DC 转换器

# 1 产品特性

- 集成高效率的 DC-DC 转换器和片上变压器
  - 内置软启电路来防止浪涌电流和输出过冲
  - 过载和短路保护功能
  - 过热关断保护功能
- 宽输入电压范围: 4.5 V~5.5 V
- 输出电压可选:
  - 3.3V \ 5.0V \ 3.7V \ 5.4V
  - 支持在输出端接 LDO
- 输出典型功率: 650mW(5V/130mA)
- 宽工作温度范围: -40 °C ~ 125 °C
- 优异的隔离性能:
  - UL 1577 标准下,长达 1 分钟的 5KV<sub>RMS</sub> 隔离耐压
  - 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071VPK VIOTM 和 849VPK VIORM
  - IEC 60950、 IEC 60601 和 EN 61010 认证 — CQC、 TUV 和 CSA 认证
  - 高 CMTI: ±150 kV/μS (典型)
  - 隔离栅寿命: >40 年
- 符合 RoHS 标准封装
  - SOIC16-WB

# 2 应用

- 工业自动化控制系统
- 电机控制
- 医疗设备
- 电网基础设备
- 测试和测量仪器

### 3 概述

CA-IS3105W 是一款支持 5KV<sub>RMS</sub> 隔离耐压的 DC-DC 转换器芯片,集成片上变压器,能够高效率传输大于

650mW 功率到副边输出。该芯片采用特有控制架构,能够快速响应负载变化,并且精确调节输出电压。CA-IS3105W 的出现可替代传统分立器件组建的隔离电源方案。该方案物理尺寸更小,且能够实现完全隔离。

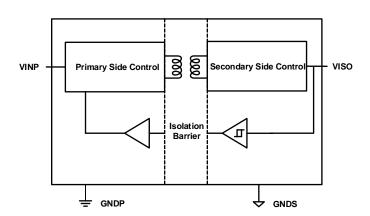
CA-IS3105W 集成软启动、短路保护、过温保护等多种保护功能以更好地增强系统的可靠性。CA-IS3105W 具有 EN 使能管脚,当 EN 为低电时,输出电压为零,此时电源仅有微安级待机输入电流。

可通过管脚 SEL 选择 4 种输出电压,分别为 5V、3.3V、5.4V、3.7V,支持输出端接 LDO,以方便用户不同的电压需求。CA-IS3105W 器件采用 16 脚宽体 SOIC 封装,绝缘耐压高达 5 kV<sub>RMS</sub>。

# 器件信息

零件号	封装	封装尺寸(标称值)
CA-IS3105W	SOIC16-WB(W)	10.30 mm × 7.50 mm

# 简化结构图





# 目录

产品特	<b>导性</b>	1
应用		1
概述		1
6.1		
6.2	ESD 额定值	4
6.3	推荐工作条件	4
6.4	热量信息	5
6.5	额定功率	5
6.6	隔离特性	6
6.7	安全相关认证	7
6.8	电气特性	8
6.9	潮敏等级	8
典型》	波形和曲线图	9
	应概修引产 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9	6.2 ESD 额定值 6.3 推荐工作条件 6.4 热量信息 6.5 额定功率 6.6 隔离特性 6.7 安全相关认证 6.8 电气特性

	7.1	软启动和输出短路恢复波形	9
	7.2	输出电压纹波以及动态特性	10
	7.3	输出电压随负载电流和输入电压的变化	11
	7.4	静效率随负载电流以及表面温度的变化	13
	7.5	静态电流 Ivin_so 随输入电压的变化	13
	7.6	输出电流降额曲线	13
8	详细说	も明	14
	8.1	工作原理	14
	8.2	功能框图	14
9	典型应	团用	15
10	PCB 有	ī板建议	15
11	封装信	意息	16
12	焊接信	··· ···	17
13	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· 息	
14		ョ明	
14	<b>坐女</b> 广	7 7/7 ······	т

# 4 修订历史

修订版本号	修订内容	修订时间	页码
Version 1.00	N/A		N/A
Version 1.01	更新 POD 和编带信息	2022.12.19	16, 18



#### 5 引脚功能描述

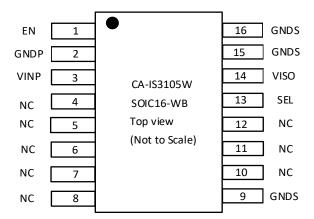


图 5-1 CA-IS3105W 顶部视图

# 表 5-1 CA-IS3105W 引脚功能描述

引脚名称	引脚编号	类型	描述
EN	1	输入	使能管脚。接高电平,使能芯片,接低电平,关断芯片。
GNDP	2	地	原边侧接地管脚。将原边的去耦电容连接在 VINP 和该管脚。
VINP	3	电源	原边侧输入电源管脚。将 10μF 和 0.1μF 的陶瓷电容接至 VINP 和 PIN2 之间,电容的摆放位置要尽量靠近芯片管脚。
	4	-	
	5	-	
NC <sup>1</sup>	6	-	无连接。原边电压域,在 PCB 板上连接至 GNDP。
	7	-	
	8	-	
GNDS	9	地	副边地管脚。
	10	-	
NC	11	-	无连接。副边电压域,在 PCB 板上连接至 GNDS。
	12	-	
SEL	13	输入	VISO 输出电压选择管脚。SEL 接至 VISO, VISO 输出 5V; SEL 通过 100K 电阻接至 VISO, VISO 输出 5.4V; SEL 接至 GNDS, VISO 输出 3.3V; SEL 通过 100K 电阻接至 GNDS, VISO 输出 3.7V。
VISO	14	电源	隔离电压输出管脚。将 10μF 和 0.1μF 的陶瓷电容接至 VISO 和 PIN15 之间,电容的摆放位置要尽量靠近芯片管脚。
GNDS	15	地	副边地管脚,将副边的去耦电容连接在 VISO 和该管脚之间。
GNDS	16	地	副边地管脚。

<sup>1.</sup> NC 引脚没有内部连接,它们可以浮空、或连接到相应的"地"。



# 6 产品规格

# 6.1 绝对最大额定值 1,2

	参数	最小值	最大值	单位
VINP	电源电压	-0.5	6.0	V
VISO	隔离电源输出电压	-0.5	6.0	V
EN	EN 输入电压	-0.5	VINP+0.3 <sup>3</sup>	V
SEL	SEL 输入电压	-0.5	VISO+0.3	V
Tj	结温	-40	150	°C
T <sub>STG</sub>	存储温度	-65	150	°C

### 备注:

- 1. 等于或超出上述绝对最大额定值可能会导致产品永久性损坏,长期在超出最大额定值条件下工作会影响产品的可靠性。
- 2. 除差分 I/O 总线电压以外的所有电压值,均相对于本地接地端子(GNDP 或 GNDS),并且是峰值电压值。
- 3. 最大电压不得超过 6 V。

# 6.2 **ESD** 额定值

		数值	单位
V <sub>ESD</sub> 静电放电	人体模型 (HBM),根据 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001,所有引脚 <sup>1</sup>	±3000	V
V <sub>ESD</sub> 静电放电	组件充电模式(CDM),根据 JEDEC specification JESD22-C101,所有引脚 <sup>2</sup>	$\pm 2000$	V
<b>各注</b> ·			

#### 备注:

- 1. JEDEC 文件 JEP155 规定 500 V HBM 可通过标准 ESD 控制过程实现安全制造。
- 2. JEDEC 文件 JEP157 规定 250 V CDM 允许使用标准 ESD 控制过程进行安全制造。

# 6.3 推荐工作条件

	参数	最小值	典型值	最大值	单位
VINP	电源电压	4.5	5	5.5	V
V <sub>EN</sub>	EN 输入电压	0		5.5	V
VISO	隔离输出电源电压	0		5.7	V
V <sub>SEL</sub>	SEL 输入电压	0		5.7	V
T <sub>A</sub>	环境温度	-40		125	°C
TJ	结温度	-40		150	°C



上海川土微电子有限公司

#### 6.4 热量信息

热量表	CA-IS3105W	単位
<b>於里</b> 仪	SOIC16-WB(W)	平位
R <sub>θJA</sub> IC 结至环境的热阻	73.8	°C/W

#### 6.5 额定功率

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
P <sub>D</sub> 最大输入功率	VINP=5.5V,VISO=5.4V,负载电流 130mA		1.27W	1.4	W

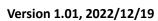
# CHIPANALOG

# 6.6 隔离特性

			数值	单位
	- ***		W	十四
CLR	外部气隙(间隙)1	测量输入端至输出端,隔空最短距离	8	mm
CPG	外部爬电距离 1	测量输入端至输出端,沿壳体最短距离	8	mm
DTI	隔离距离	最小内部间隙(内部距离)	21	μm
CTI	相对漏电指数	DIN EN 60112 (VDE 0303-11); IEC 60112	>400	V
	材料组	依据 IEC 60664-1	I	
		额定市电电压≤ 300 V <sub>RMS</sub>	I-IV	
	IEC 60664-1 过压类别	额定市电电压≤ 400 V <sub>RMS</sub>	I-IV	
		额定市电电压 ≤ 600 V <sub>RMS</sub>	1-111	
DIN V VI	DE V 0884-11:2017-01 <sup>2</sup>			
V <sub>IORM</sub>	最大重复峰值隔离电压	交流电压(双极)	849	$V_{PK}$
	目上工水原家中厅	交流电压;时间相关的介质击穿 (TDDB) 测试	600	V <sub>RMS</sub>
V <sub>IOWM</sub>	最大工作隔离电压	直流电压	849	$V_{DC}$
V <sub>IOTM</sub>	最大瞬态隔离电压	V <sub>TEST</sub> = V <sub>IOTM</sub> , t = 60 s (认证); V <sub>TEST</sub> = 1.2 × V <sub>IOTM</sub> , t= 1 s (100% 产品测试)	7070	$V_{PK}$
V <sub>IOSM</sub>	最大浪涌隔离电压3	测试方法 依据 IEC 60065,1.2/50 μs 波形, V <sub>TEST</sub> = 1.6 × V <sub>IOSM</sub> (生产测试)	6250	$V_{PK}$
<b>q</b> <sub>pd</sub>	表征电荷 4	方法 a,输入/输出安全测试子类 2/3 后, V <sub>ini</sub> = V <sub>IOTM</sub> , t <sub>ini</sub> = 60 s; V <sub>pd(m)</sub> = 1.2 × V <sub>IORM</sub> , t <sub>m</sub> = 10 s 方法 a,环境测试子类 1 后, V <sub>ini</sub> = V <sub>IOTM</sub> , t <sub>ini</sub> = 60 s;	≤5 ≤5	pC
		V <sub>pd(m)</sub> = 1.6 × V <sub>IORM</sub> , t <sub>m</sub> = 10 s         方法 b1, 常规测试 (100% 生产测试) 和前期预处理(抽样测试)         V <sub>ini</sub> = 1.2 × V <sub>IOTM</sub> , t <sub>ini</sub> = 1 s;         V <sub>pd(m)</sub> = 1.875 × V <sub>IORM</sub> , t <sub>m</sub> = 1 s	≤5	
C <sub>IO</sub>	栅电容,输入到输出5	$V_{IO} = 0.4 \times \sin(2\pi ft), f = 1 \text{ MHz}$	3.5	pF
		V <sub>IO</sub> = 500 V, T <sub>A</sub> = 25°C	>1012	
R <sub>IO</sub>	绝缘电阻 5	$V_{IO} = 500 \text{ V}, 100^{\circ}\text{C} \le T_{A} \le 125^{\circ}\text{C}$	>1011	Ω
		V <sub>IO</sub> = 500 V at T <sub>S</sub> = 150°C	>109	
	污染度		2	
UL 1577				
V <sub>ISO</sub>	最大隔离电压	V <sub>TEST</sub> = V <sub>ISO</sub> ,t = 60 s (认证) V <sub>TEST</sub> = 1.2 × V <sub>ISO</sub> ,t = 1 s (100%生产测试)	5000	$V_{RMS}$
H 11.				

### 备注:

- 1. 根据应用的特定设备隔离标准应用爬电距离和间隙要求。注意保持电路板设计的爬电距离和间隙距离,以确保印刷电路板上隔离器的安装焊盘不会缩短该距离。在某些情况下印刷电路板上的爬电距离和间隙相等。在印刷电路板上插入凹槽的技术有助于提高这些指标。
- 2. 该标准仅适用于安全等级内的安全电气绝缘。应通过适当的保护电路确保符合安全等级。
- 3. 测试在空气或油中进行,以确定隔离屏障的固有浪涌抗扰度。
- 4. 表征电荷是由局部放电引起的放电电荷(pd)。
- 5. 栅两侧的所有引脚连接在一起,形成双端子器件。





# 6.7 安全相关认证

上海川土微电子有限公司

VDE(申请中)	CSA(申请中)	UL(申请中)	CQC(申请中)	TUV(申请中)
根据 DIN V VDE V 0884- 11:2017-01 认证	根据 IEC60950-1,IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 认证	UL1577 器件认证程序认证	根据 GB4943.1-2011 认 证	根据 EN61010-1:2010 (3rd Ed)和 EN 60950- 1:2006/A2:2013 认证



# 6.8 电气特性

若无其他特殊说明,VINP=4.5V~5.5 V, $T_A$  = -40 to 125°C,SEL 管脚短路到 VISO 管脚, $C_{VINP}$ = $C_{VISO}$ =10μF。所有典型值的条件为  $T_J$ =25°C 和 VINP=5V。

		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
输入供电							
I <sub>VINP_SD</sub>	EN 关断时输入静态电流	EN=LOW,图 7- 27		0.05	10	μΑ	
		EN=HIGH,SEL 短路到 VISO (5V 输出),图 7- 28		8.4	20	mA	
i	工及共吐松) 整大电流	EN=HIGH,SEL 通过 100K 接到 VISO (5.4V 输出)		8.8	20	mA	
$I_{VINP\_O}$	无负载时输入静态电流	EN=HIGH,SEL 短路到 GNDS (3.3V 输出)		7.3	20	mA	
		EN=HIGH,SEL 通过 100K 接到 GNDS (3.7V 输出)		7.5	20	mA	
I <sub>VINP_SC</sub>	VISO 管脚发生短路时的输入电源 电流平均值	VISO 脚短路到 GNDS		42	100	mA	
$V_{UVLO+}$	电源上升过程的欠压保护阈值			2.6	3.0	V	
$V_{\text{UVLO-}}$	电源下降过程的欠压保护阈值		2.1	2.3		V	
V <sub>HYS(UVLO)</sub>	电源欠压保护阈值迟滞			0.3	0.6	V	
逻辑管脚物	特性						
$V_{IH\_EN}$	EN 输入高电平		2			V	
V <sub>IL_EN</sub>	EN 输入低电平				0.8	V	
I <sub>EN</sub>	输入漏电流	VINP=5V, $V_{EN} = 5V$		5	20	μΑ	
隔离 DC-D	C 转换器						
		SEL 接至 VISO(5V 输出),I <sub>ISO</sub> =50mA	4.65	5.0	5.35		
VISO	隔离输出电压	SEL 通过 100KΩ 接至 VISO(5.4V 输出),I <sub>ISO</sub> =50mA	5.02	5.4	5.78	V	
VISO	<b>州内州山 七</b> 丛	SEL 接至 GNDS(3.3V 输出),I <sub>ISO</sub> =50mA	3.07	3.3	3.53		
		SEL 通过 100KΩ 接至 VISO(3.7V 输出),I <sub>ISO</sub> =50mA	3.44	3.7	3.96		
	输出隔离电压纹波(峰峰值)	20MHz 带宽,SEL 短路到 VISO (5V 输出), IISO = 100 mA ,图 7-9		65	100	mV	
VISO <sub>(RIP)</sub>		20MHz 带宽,SEL 短路到 GNDS (3.3V 输出), IISO = 100 mA ,图 7- 11		55	100		
	直流线性调整率	SEL 短路到 VISO (5V 输出),IISO = 50 mA,VINP = 4.5 V to 5.5 V ,图 7- 21		2	5	mV/V	
VISO <sub>(LINE)</sub>		SEL 短路到 GNDS (3.3V 输出),IISO = 50 mA, VINP = 4.5 V to 5.5 V ,图 7- 23		2	5		
		SEL 短路到 VISO (5V 输出),IISO = 0 to 130		1%	2%		
$VISO_{(LOAD)}$	直流负载调整率	mA,图 7- 17 SEL 短路到 GNDS (3.3V 输出),IISO = 0 to 130				1	
		mA,图 7-19		1%	2%		
EFF	最大负载电流时的效率	$I_{ISO}$ = 130 mA, $C_{LOAD}$ = 0.1 μF    10 μF;VISO=5V,图 7- 25,图 7- 26		55%			
LII	以ハスれでMirt IIJ从平	$I_{ISO}$ = 130 mA, $C_{LOAD}$ = 0.1 μF    10 μF;VISO=3.3V,图 7- 25,图 7- 26		48%			
CMTI	共模瞬变抗扰度	GNDP VS GNDS 的斜率,V <sub>CM</sub> =1200V <sub>RMS</sub>	±100	±150		kV/μs	
动态负载过冲		10%和 100%负载跳变,上升斜率 10mA/us;测量两种负载下输出电压的波峰的差值。图 7-13,图 7-14,图 7-15,图 7-16		80	100	mV	
瞬时过载了	功率	VINP=5V, VISO=5.4V	1			W	

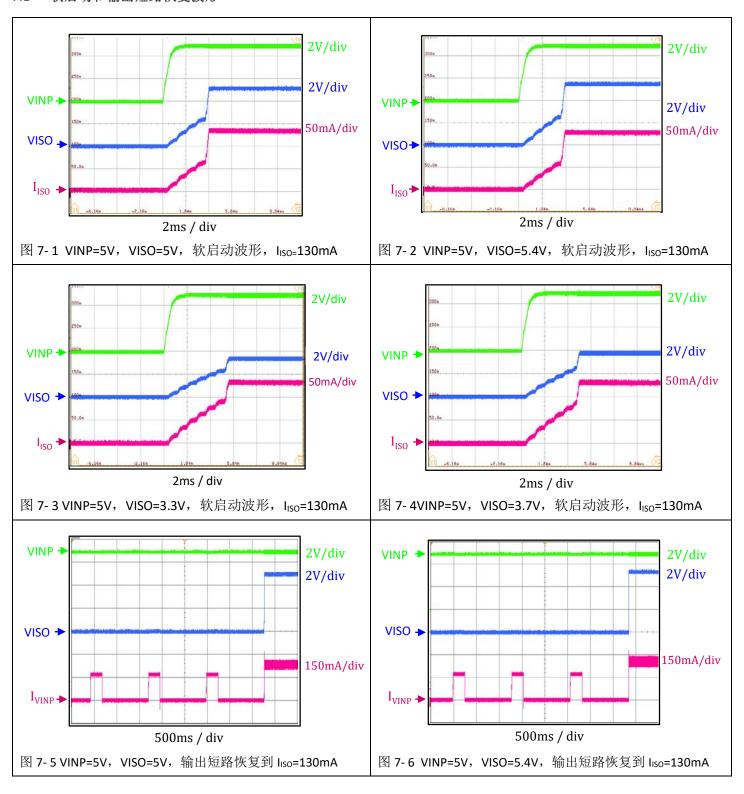
# 6.9 潮敏等级

参数	标准	等级
潮敏等级	IPC/JEDEC J-STD-020D.1	MSL 3

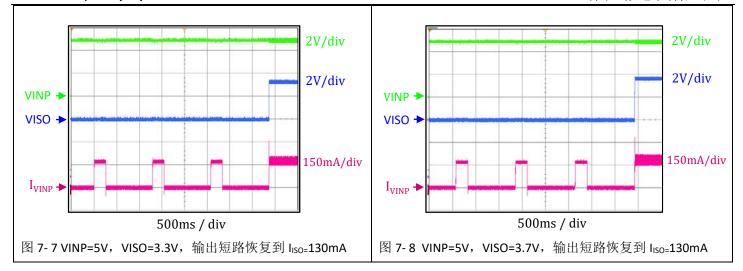


# 上海川土微电子有限公司 典型波形和曲线图

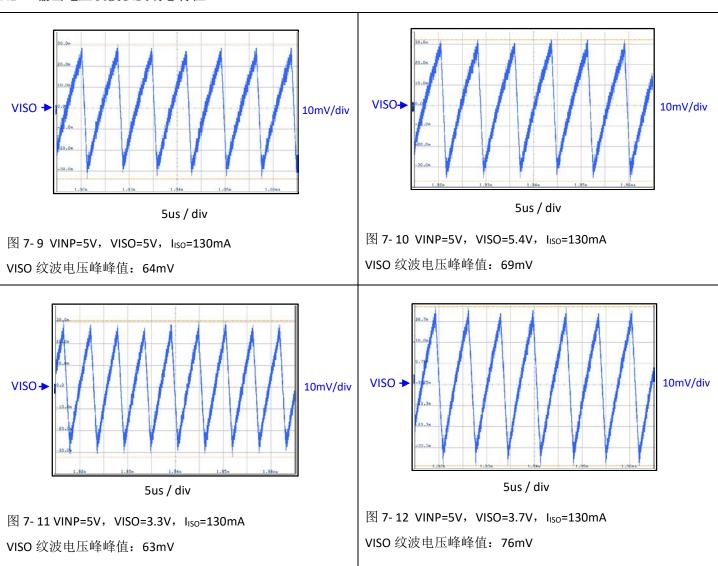
#### 软启动和输出短路恢复波形 7.1







# 7.2 输出电压纹波以及动态特性



# 上海川土微电子有限公司

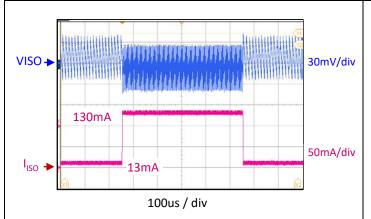


图 7- 13 VINP=5V, VISO=5V, 13mA/130mA 13mA/130mA 时的 VISO 纹波电压波峰的差值: 16mV

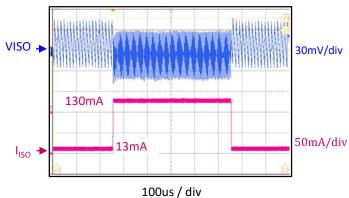


图 7- 14 VINP=5V, VISO=5.4V, 13mA/130mA 13mA/130mA 时的 VISO 纹波电压波峰的差值: 17mV

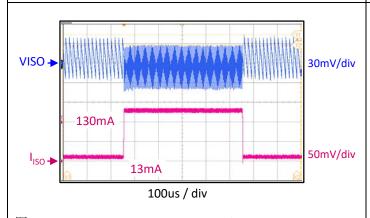


图 7- 15 VINP=5V,VISO=3.3V,13mA/130mA 13mA/130mA 时的 VISO 纹波电压波峰的差值: 15mV

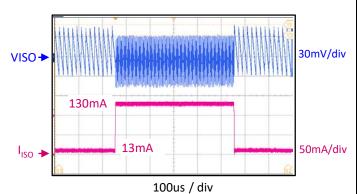
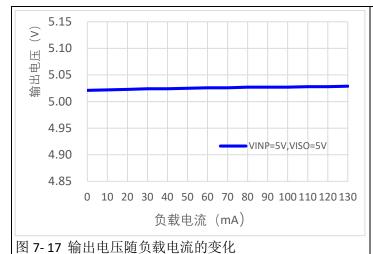


图 7- 16 VINP=5V,VISO=3.7V,13mA/130mA 13mA/130mA 时的 VISO 纹波电压波峰的差值: 16mV

### 7.3 输出电压随负载电流和输入电压的变化



VINP=5V, VISO=5V

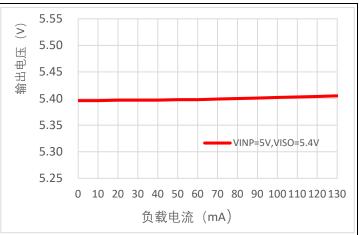


图 7- 18 输出电压随负载电流的变化 VINP=5V, VISO=5.4V



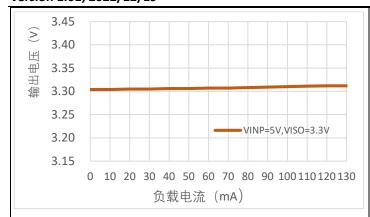


图 7-19 输出电压随负载电流的变化

VINP=5V, VISO=3.3V

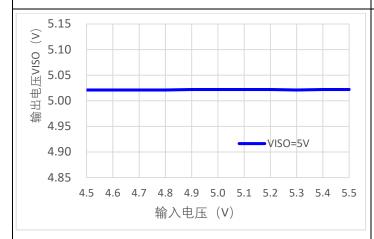


图 7-21 输出电压随输入电压的变化

VINP=4.5~5.5V, VISO =5V

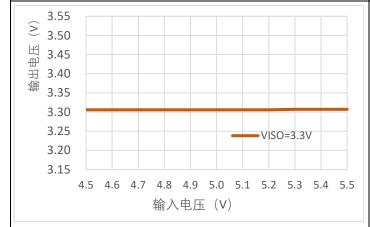


图 7-23 输出电压随输入电压的变化

VINP=4.5~5.5V, VISO =3.3V

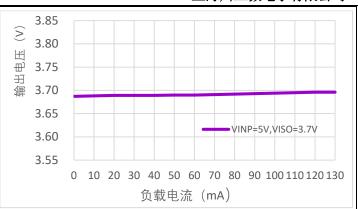


图 7-20 输出电压随负载电流的变化

VINP=5V, VISO=3.7V

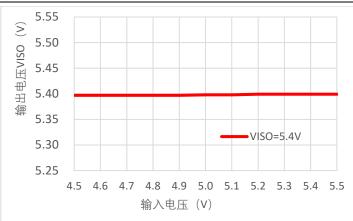


图 7-22 输出电压随输入电压的变化

VINP=4.5~5.5V, VISO =5.4V

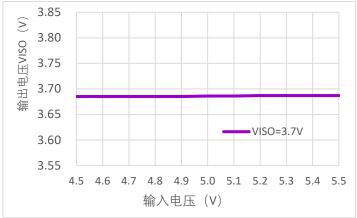


图 7-24 输出电压随输入电压的变化

VINP=4.5~5.5V, VISO=3.7V



上海川土微电子有限公司

#### 静效率随负载电流以及表面温度的变化 7.4

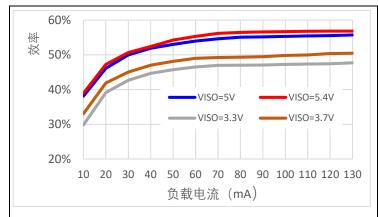


图 7-25 效率随负载电流的变化

VINP=5V, VISO=5V; VINP=5V, VISO=5.4V; VINP=5V, VISO =3.3V; VINP=5V, VISO=3.7V

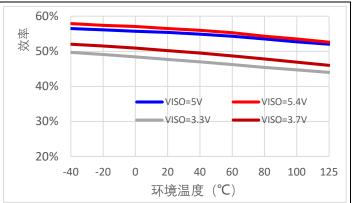


图 7-26 效率随芯片表面温度的变化

VINP=5V, VISO=5V; VINP=5V, VISO=5.4V; VINP=5V, VISO =3.3V; VINP=5V, VISO=3.7V

#### 静态电流 Ivin\_sd 随输入电压的变化 7.5

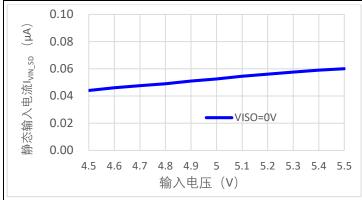


图 7-27 EN 使能关断时,输入静态电流 IVIN\_SD 随输入电 压的变化 VINP=4.5~5.5V, EN 管脚接 GNDP

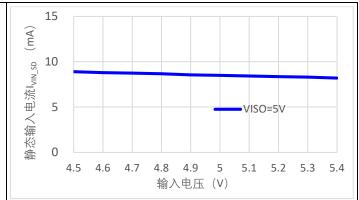


图 7-28 EN 使能时,输入静态电流 IVIN\_SD 随温度的变

VINP=4.5~5.5V, VISO=5V, EN 管脚接 VINP

#### 输出电流降额曲线 7.6

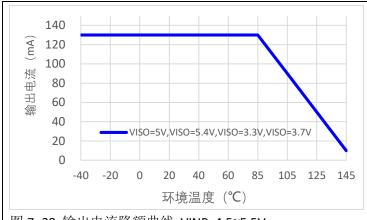


图 7-29 输出电流降额曲线 VINP=4.5~5.5V

# 8 详细说明

### 8.1 工作原理

CA-IS3105W 是一款支持 5KVrms 隔离耐压的 DC-DC 转换器芯片,集成片上变压器,能够高效率传输大于 650mW 功率到副边输出。CA-IS3105W 产品的功能框图如图 8-1 所示。

该芯片采用特有的隔离控制架构,能够快速响应负载变化,并且精确调节输出电压。VINP 电源供电给一个振荡电路,该电路将能量传输给一个高 Q 值的片上变压器,该变压器具有高效率和低辐射性能。根据 SEL 引脚的设置,传递到副边的能量被调节成 3.3 V/5 V 或 3.7 V/5.4 V(通过 SEL 管脚来选择)的输出电压。副边(VISO)控制器将 PWM 控制信号通过一个专用的隔离数据通道传递给原边,原边依据副边反馈的 PWM 信号调节传输能量。VINP 和 VISO 电源上都具备带迟滞的欠压锁定(UVLO)保护,保证了系统在噪声条件下的良好性能。内置的软启动电路确保了不会出现浪涌电流和输出电压过冲。

CA-IS3105W 内置短路保护功能。当输出电压 VISO 短路到地后,芯片进入 Hiccup 模式,表现为芯片输出每关闭一段时间后再尝试软起动上电,不断循环,直到短路故障清除,输出自动软起动恢复正常。

### 8.2 功能框图

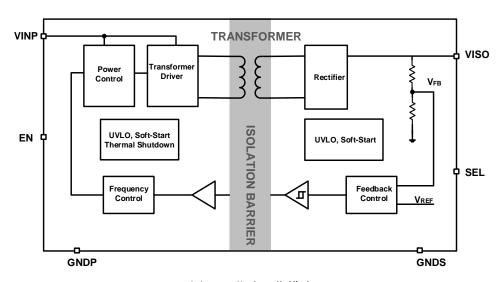


图 8-1 芯片工作模式

通过 EN 管脚可以控制输出端是否有电压,当 EN 为低电平时,输出为 OV;当 EN 为高电平时,通过 SEL 管脚的接线方式,输出电压有 5V、3.3V、5.4V、3.7V 等 4 种选项。表 8-1 输出电源真值表为 CA-IS3105W 输出电压真值表。

EN	SEL	VISO
HIGH	短接到 VISO	5V
HIGH	通过 100K 电阻接至 VISO	5.4V
HIGH	短接到 GNDS	3.3V
HIGH	通过 100K 电阻接至 GNDS	3.7V
HIGH	OPEN <sup>1</sup>	不支持
LOW	Х	0V

表 8-1 输出电源真值表

1. 应用时不推荐把 SEL 管脚悬空。



# 9 典型应用

CA-IS3105W 芯片只需要在外部接上适当的储能电容就可以工作,电容放置在尽可能靠近芯片管脚的位置。图 9-1 显示了 CA-IS3105W 芯片的典型应用。

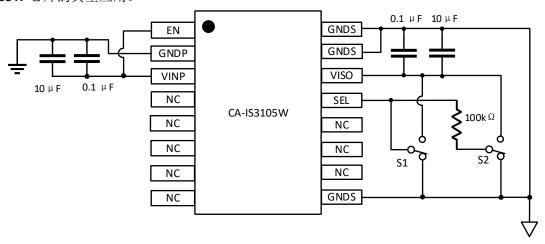


图 9-1 CA-IS3105W 典型应用电路

### 10 PCB 布板建议

建议在隔离器下方保留一个远离地线和信号线的隔离通道,电缆侧和逻辑侧之间的任何电气连接或金属连接,都会降低隔离度。为确保器件在任何数据速率下可靠工作,建议在  $V_{CC}$  与 GNDA、 $V_{ISO}$  与 GNDB 之间外接  $10\mu$ F 的去耦电容。并且电容器应紧靠器件相应的电源引脚放置。实际应用中,输入和输出电容为  $10\mu$ F 和  $0.1\mu$ F 电容并联,且  $0.1\mu$ F 电容靠近芯片引脚摆放,距离控制在 2mm 以内。PCB 板上输入、输出电容和芯片必须放在芯片同一层,不要将电容和芯片放在不同层且通过过孔相连。推荐 PCB 隔离电源部分走线如图 10-1 所示。

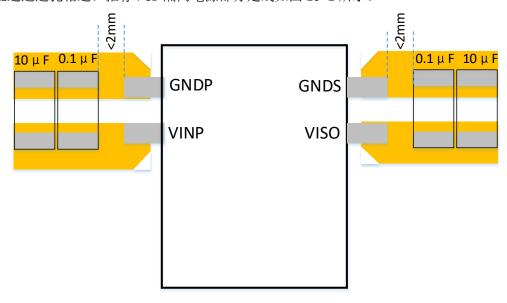
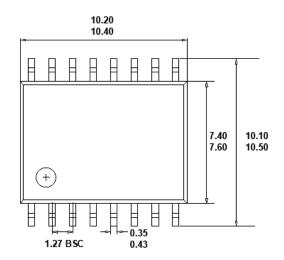


图 10-1 推荐 PCB 电源部分走线

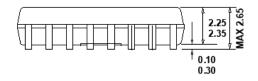


# 11 封装信息

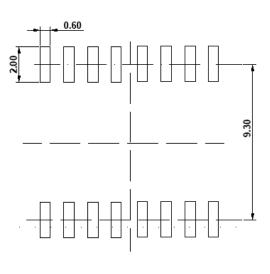
下图说明了 CA-IS3105W 隔离 DC-DC 采用的 SOIC-16WB 宽体封装大小尺寸图和建议焊盘尺寸图,尺寸以毫米为单位。



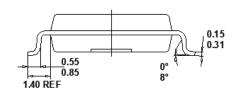




**FRONT VIEW** 



RECOMMMENDED LAND PATTERN



LEFT SIDE VIEW



# 12 焊接信息

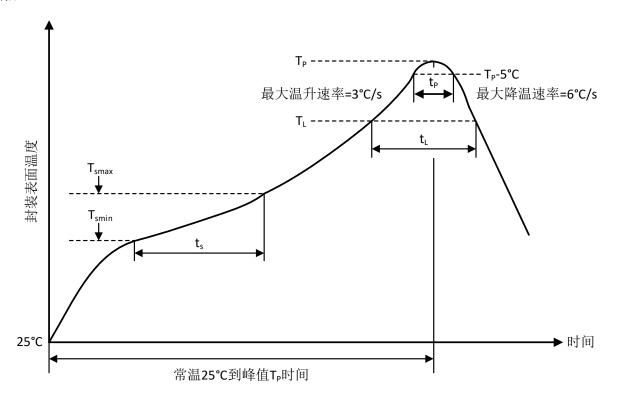


图 12-1 焊接温度曲线

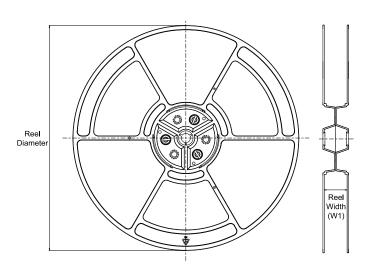
表 12-1 焊接温度参数

简要说明	无铅焊接
温升速率(T∟=217°C 至峰值 T <sub>P</sub> )	最大 3°C/s
T <sub>smin</sub> =150°C 到 T <sub>smax</sub> =200°C 预热时间 t <sub>s</sub>	60~120 秒
温度保持 217℃ 以上时间 tL	60~150 秒
峰值温度 T <sub>P</sub>	260°C
小于峰值温度 5℃ 以内时间 tp	最长 30 秒
降温速率(峰值 T₂至 T₂=217°C)	最大 6°C/s
常温 25℃ 到峰值温度 Tp时间	最长8分钟

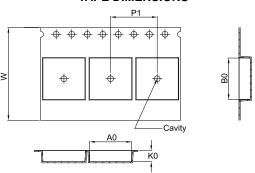


# 13 编带信息

### REEL DIMENSIONS

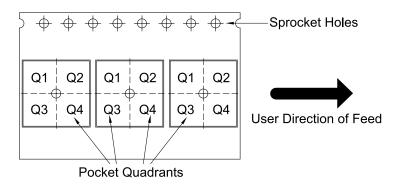


# TAPE DIMENSIONS



Α0	Dimension designed to accommodate the component width					
В0	Dimension designed to accommodate the component length					
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness					
W	Overall width of the carrier tape					
P1	Pitch between successive cavity centers					

### **QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE**



### \*All dimensions are nominal

	Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
I	CA-IS3105W	SOIC	W	16	1000	330	16.4	10.9	10.7	3.2	12.0	16.0	Q1



# 14 重要声明

上述资料仅供参考使用,用于协助 Chipanalog 客户进行设计与研发。Chipanalog 有权在不事先通知的情况下,保 留因技术革新而改变上述资料的权利。

Chipanalog 产品全部经过出厂测试。针对具体的实际应用,客户需负责自行评估,并确定是否适用。Chipanalog 对客户使用所述资源的授权仅限于开发所涉及 Chipanalog 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源, 如因 使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等, Chipanalog 对此概不负责。

### 商标信息

Chipanalog Inc.®、Chipanalog®为 Chipanalog 的注册商标。



http://www.chipanalog.com